			HUPINITION	ЗОНО	/ <i>IU3.</i>		Обозни		up	Наименовани	'IP	Кол.	Приме-
		9	<i>'n'</i>	J. J.	_					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			<i>ЧФНИР</i>
	примен.	F								Локимоитан	u a		
	д у	\vdash	+	+						<u>Документац</u>	<u>ИЯ</u>		
	16t	A	11			NY4.11.03	3.03.24.	05.52	2.37.001 33	Схема электриче	СКОЯ	1	
										принципиальная			
ŀ	+	— [A	3			ИУ4.11.03	3.03.24.	05.52	2.37.001 СБ	Сборочный черте	'X'	1	
										электронной яче	ŪKU		
		A	3			ИУ4.11.0.	3.03.24	4.05	<i>52.37.002</i>	Плата печатная		1	
	No	L											
	прав									<u>Детали</u>			
)	A	3		1	ИУ4.11.0.	3.03.24	4.05	<i>52.37.002</i>	Плата печатная		1	
		L											
		4								Прочие издел	<u> ЛИЯ</u>		
ζ.		F								4			
ірава зацицены І		\vdash	<u>Антенны</u> 2 SW868-TH13				1	11					
1) 30m		┽	+		_					SW868-TH13	nav Co. Itd	/	A1
npap	и дата	\vdash	+	+						(NiceRF Wireless Technolo Kumaū)	IYY LU., LIU.,		
ig Bre r		F	+							Λυπιω)			
Россия	Подг	\vdash	+	+						Динамики			
"СНЦЯ",	7.	╬	+		3					KP1838M1F-1208		1	BA1
проектиравания",	д дуб,	H		+						(Ningbo Kepo Electroni	irs (n l td		DITT
npoek	<i>√V. V</i>	F								китай)	<i>L3 CU.,L1u,</i>		
CTTPPM6/	tM oı	╬								710///40)			
77	HB. N		\dagger	\dagger						Диоды			
000 "ACKOH	מאי רי		\dagger		4					1N4148 (Diotec Semico	anductors.	5	VD1, VD2
	Вз	\dashv								Германия)	,		VD3, VD4
Учедная версия © 2024	Тодп. и дата									,			VD5
) <i>KNJ</i> (
ы ва		F			\vdash				I/U/	4.11.03.03.24.0	75523	770	101
				/ <u> UCITI</u>		N° докум.	Подп.	Дата	<i>VIJ</i> 4	+. 1 1.UJ.UJ.Z 4.U 			
D 123.	подл.		'0.3 <u> </u> pol	7αδ. 3.		оветников М.М. Еливанов К.В.			Высокоч	увствительный		<u>Лист</u> 1	<u>Листов</u> 4
TAC-3	B. No	1	Н.контр. Утв.					приемник			ГУ им. Н.Э. Бауиана Кафедра ИУ4		
KOX	1 MHL	۷					Епецификиция Груп			nna N94–526			
	He dn	1Я KOI	MMPJ	Э <i>ЧЕСК</i> І	020	использования	Я		Копиров	<u> </u>	Фор	ΜΩΠ	A4

	эормат.	Поз.	Ωδορμαμομμο	<u> </u>	Кол.	Приме-
	Формат. Эпна		Обозначение	Наименование	Ж	<i>Чание</i>
	П			_Дроссели		
		5		B82111E0000C022	1	<i>L1</i>
				(EPCOS, Германия)		
		6		FWCMT6052221K	2	<i>L2, L3</i>
				(Ferriwo, Kumaū)		
				<u>Конденсаторы</u>		
		7		К10-17Б 10 пФ 50В 5%	1	[1
				(JB Capacitors, Kumaū)		
		8		KΠK-MH 8/30 nΦ 350 B	1	<i>[2</i>
				(OXO.460.207 TY)		
		9		К10-17Б 0,1 мкФ 50В 10%	4	<i>C3, C8</i>
				(JB Capacitors, Kumaū)		C21, C25
		10		K10-17Б 1000 пФ 50В 5%	8	£4, £5
197				(JB Capacitors, Kumaū)		<i>C13, C14</i>
מלחת						C16, C18
poba sautuutere. ma						[19, [20]
Все пр и дати		11		К10-17Б 510 пФ 50В 5%	1	[2
Россия Б Подп. и				(JB Capacitors, Kumaū)		
· I I		12		K50-35 47 MKΦ 10B 20%	4	C7, C10
бания 5л.				(JB Capacitors, Kumaū)		<i>C15, C17</i>
істечы проектирования", Nº Инв. Nº дцбл.		13		GZN60100 (Sprague-Goodman	1	<u>[9</u>
. лров И.В. Л				Electronics, CWA)		
INPMB/	\Box	14		К10-17Б 68 пФ 50В 5%	1	[11
7				(JB Capacitors, Kumaū)		
оо "АСКОН- Взам. инб		15		K10-175 0,01 MKΦ 50B 10%	2	[12, [23]
a				(JB Capacitors, Kumaū)		<u> </u>
© 2024. Tama		16		K50-35 10 MKΦ 16B 20%	1	[22
ля © 21 и дата				(JB Capacitors, Kumaū)		
я верг		17		K50-35 100 MKΦ 10B 20%	1	[24
Чедна П.	$ \uparrow $			(JB Capacitors, Kumaū)		
30 v23 Учедная версия Nº подл. Подп. и б	$\parallel \parallel$					
No 111	片	I	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14.02.02.04.05.50.25	7.00	n /lucm
WHB.	Изм. //	lucm	№ докум. Подп. Дата	<i>11.03.03.24.05.52.37.</i>	UÜ	$\frac{11}{2}$
Не для г			т использования — Копиров Писпользования	вал Фор	МДП	A4

Шиши	ЗОНа	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
ľ				Разъемы		
		18		KLS2-300-5.00-02P-2S	1	XS1
				(KLS electronic co itd, Kumaū)	,	7,07
				Резисторы		
		19		CF-25 100k0m 0,25Bm 5%	4	R1, R2
				(Уадео, Тайвань)	,	R8, R12
		20		CF-25 1kOm 0,25Bm 5%	4	R3, R7
		20		(Үадео, Тайвань)		R21, R22
		21		CF-25 3kOm 0,25Bm 5%	5	R4, R5
		2 /		(Үадео, Тайвань)		R10, R14
				Trageo, rassans,		R17
		22		CF-25 270k0m 0,25Bm 5%	2	R6, R11
				(Үадео, Тайвань)		110, 1111
<i>)</i> 9		23		CF-25 56kOm 0,25Bm 5%	3	R9, R13
100 3000 46.16 100 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000		23		(Үадео, Тайвань)		R18
		24		CF-25 1,8kOm 0,25Bm 5%	1	R15
е пра Зата				(Үадео, Тайвань)		7(1)
исия вен 10дп. и дал 		25		CF-25 10k0m 0,25Bm 5%	1	R16
7007		23		(Үадео, Тайвань)		7770
		26		16K1–10C10K (Song Huei	1	R19
o dyδn.		20		Electronic, Kumaū)		1177
MHO. N		27		CF-25 5,1kOm 0,25Bm 5%	1	R20
		2 /		(Үадео, Тайвань)		7120
46. Nº				rageo, rassans,		
ы Аккин-С Взам. инв.				Транзисторы		
<i>B3</i> 1		27		KT368AM	3	VT1, VT2
7024 1024				(aA0.365.025 TY)		V73
ы иңлия © 20 Тодп. и дата 		28		KT3615	4	VT4, VT6
7 10f0.				(ΦЫ0.336.201 TY)		VT8, VT14
	\dagger	29		KT3156	7	V75, V77
1.00 J	\dagger			(XK3.365.200 TY)	<u> </u>	VT9, V10
ИУИАL-ЭИ VZ3 Ученная Версия Ф 2024, UUU АLКИН-Цитемы проемпирования, Россия, Все пр ИНВ. № подл. Подп. и дата Взам. инВ. № ИНВ. № дубл. Подп. и дат. S. П.					7.00	/
MHB	3м. Ли		V° докум. Подп. Дата	<i>11.03.03.24.05.52.37.</i>	UÜ	$\frac{71}{3}$
< 1 M3			v vukum, moon, gumu Konupol Icno/Ib3oBahuя Konupol	вал Фор	МДПТ	A4

	Формат	Зона	Поз.	Ol	<i>бозначе</i>	HUP		На	ТИМЕНОЙ	вание	Кол	Πp	UME- HUE
	5											VT1	1, VT12
												1	<i>T13</i>
									Фильт	7ДЫ			
			30					Φ/71/71-	61-08		1		7Q1
								(ОДО.20	16.U14 i	19/			
												-	
H6.													
odba saujuujerisi. 7a													
Все права и дата													
Рассия Вс Падп. и и													
	L												
тирования) в дубл.													
ы проект. Инв. N ^o u													
-CUCTIENSI	┡												
Взам. ини													
ОМЛАС-3D v23 Учедная версия © 2024 Инв. Nº подл. Падп. и дата													
ія версі. Тодп. и													
3 4420H	lacksquare												
-30 v2 Nº noð,		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	T							Лист
KOMTAL WHB. 1	Изм	1. /IUI		№ докцм.	Подп. Дат		194. 1	11.03.0	13.24.0	05.52.	37.00	91	/IULIII 4
Не для			CK020	использования			Копиров	Ω/1			Формал	, A4	